



**HAL**  
open science

# Technologie des composants actifs et leur assemblage - Packaging - École Thématique CNRS 2019 Fiabilité et Sûreté de Fonctionnement

Cyril Buttay

► **To cite this version:**

Cyril Buttay. Technologie des composants actifs et leur assemblage - Packaging - École Thématique CNRS 2019 Fiabilité et Sûreté de Fonctionnement. Doctorat. France. 2019. cel-02291508

**HAL Id: cel-02291508**

**<https://cel.hal.science/cel-02291508v1>**

Submitted on 18 Sep 2019

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

École Thématique CNRS 2019  
 Fiabilité et Sûreté de Fonctionnement

*De la physique d'endommagement des composants de puissance  
 à la sûreté de fonctionnement des convertisseurs statiques*



## CM2.1

Technologie des composants actifs et leur assemblage

## Packaging

Cyril BUTTAY



Depuis 80 ans, nos connaissances  
 bâtissent de nouveaux mondes



*Saint-Pierre d'Oléron  
 Du 17 au 21 Juin 2019*

# Sommaire

Introduction

Petit lexique du packaging de puissance

Considérations physiques

- Aspects thermiques

- Aspects thermo-mécaniques

- Aspects électriques

Éléments de technologie

- Substrats

- Interconnexions

- Gestion thermique

Évolutions, Recherche et Développement

# Sommaire

## Introduction

Petit lexique du packaging de puissance

Considérations physiques

- Aspects thermiques

- Aspects thermo-mécaniques

- Aspects électriques

Éléments de technologie

- Substrats

- Interconnexions

- Gestion thermique

Évolutions, Recherche et Développement

# De quoi va t-on parler ?

De *packaging*!  
(Environnement immédiat des composants)

# De quoi va t-on parler ?

## De *packaging*!

(Environnement immédiat des composants)

Il assure :

- ▶ Connexions électriques
- ▶ Isolation électrique
- ▶ Évacuation de la chaleur
- ▶ Protection contre l'extérieur

# De quoi va t-on parler ?

## De *packaging*!

(Environnement immédiat des composants)

Il assure :

- ▶ Connexions électriques
- ▶ Isolation électrique
- ▶ Évacuation de la chaleur
- ▶ Protection contre l'extérieur

Mais on va se limiter :

- ▶ À l'électronique de puissance
- ▶ Aux composants actifs (puces)
- ▶ À une initiation au sujet. . .

# Objectifs de cette présentation

## Voir les domaines physiques concernés par le packaging

- ▶ électricité
- ▶ thermique
- ▶ mécanique...

## Vous donner des éléments de technologie

- ▶ Comprendre l'existant, pour pouvoir faire des choix

## Discuter un peu des développements futurs

- ▶ Évolutions de l'industrie
- ▶ Axes de recherche



# Sommaire

Introduction

Petit lexique du packaging de puissance

Considérations physiques

Aspects thermiques

Aspects thermo-mécaniques

Aspects électriques

Éléments de technologie

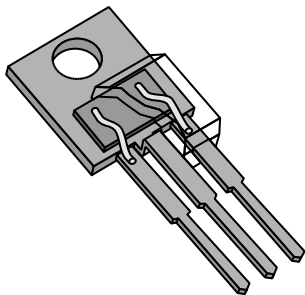
Substrats

Interconnexions

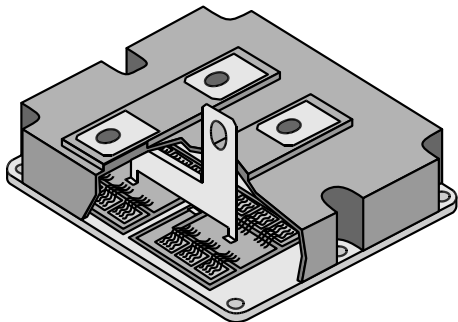
Gestion thermique

Évolutions, Recherche et Développement

## Deux classes : discrets et modules



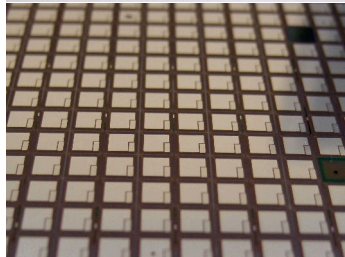
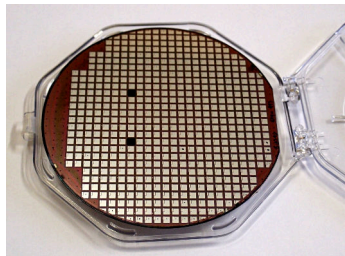
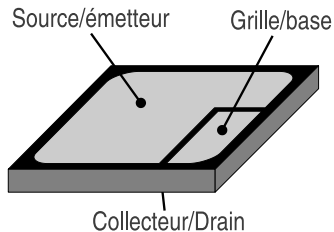
- ▶ Un composant élémentaire (transistor, diode) par boîtier
- ▶ (souvent) Pas d'isolation
- ▶ puissances faibles ou très fortes



- ▶ Plusieurs puces par boîtier
- ▶ Forme un circuit ou un seul composant élémentaire
- ▶ Assure l'isolation électrique
- ▶ Puissances moyennes à fortes

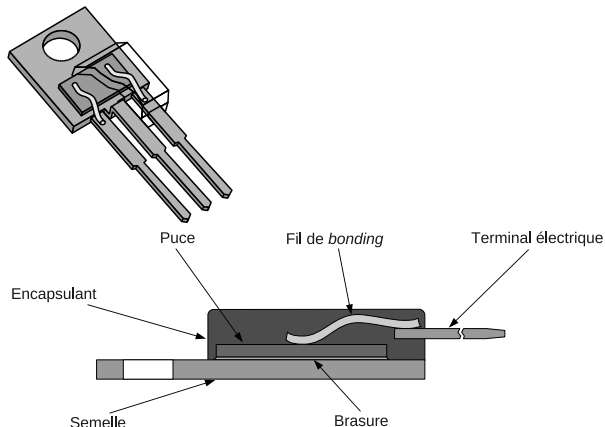
# Puces de puissance

- ▶ Structure verticale, avec un (ou deux) contacts dessus et un dessous
- ▶ épaisseur de 50 à 500  $\mu\text{m}$
- ▶ côté de 1 à 13 mm

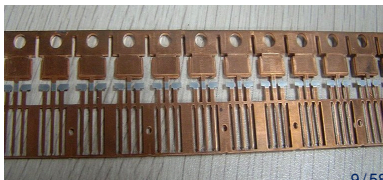


wafer IGBT International Rectifier, puces de 5x5 mm, wafer diamètre 6 pouces

# Structure d'un boîtier discret

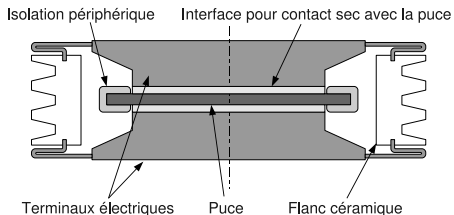


- ▶ technologie bas coût ;
- ▶ grande cadence de production ;
- ▶ matériaux : cuivre, brasure, aluminium, epoxy
- ▶ courant max. < 100 A



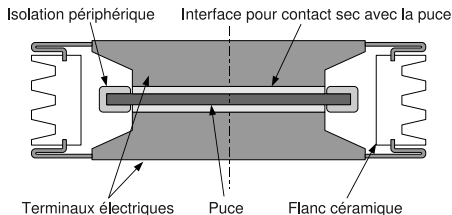
# Les discrets pour la forte puissance

- ▶ Tensions jusqu'à 6.5 kV
- ▶ Courants de plusieurs kA
- ▶ Puces jusqu'à 10 cm diam.
- ▶ conçus pour la mise en série.



# Les discrets pour la forte puissance

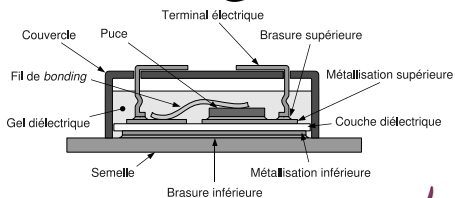
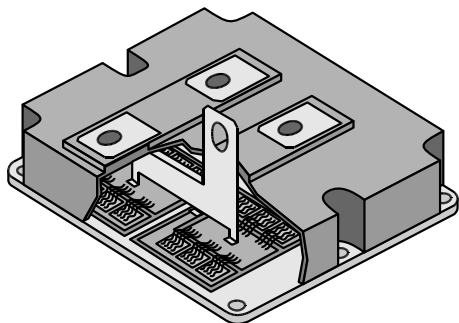
- ▶ Tensions jusqu'à 6.5 kV
- ▶ Courants de plusieurs kA
- ▶ Puces jusqu'à 10 cm diam.
- ▶ conçus pour la mise en série.



Source : <http://www.sensorprod.com>

# Modules

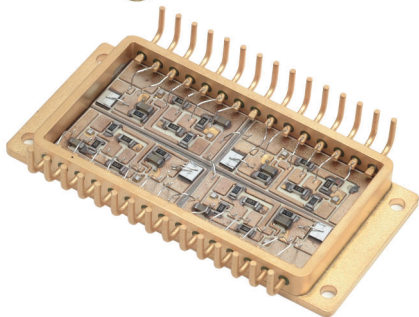
- ▶ Plusieurs puces
  - ▶ un composant équivalent (transistor, diode)
  - ▶ un circuit complet (onduleur, redresseur...)
- ▶ Besoin d'isolation électrique
- ▶ Peu standardisé
- ▶ Courant max < 3600 A
- ▶ Tension max < 6500 V
- ▶ Dimensions de qqes cm de côté à 20x15x5 cm
- ▶ Plusieurs constructeurs européens (ABB, Infineon, Microsemi, Dynex, Semikron...)



# Modules



- ▶ Plusieurs types de boîtiers
  - ▶ Plastique
  - ▶ Hermétique
- ▶ Ajout de fonctions
  - ▶ capteurs (courant, température)
  - ▶ circuits de commande
  - ▶ ...



Sources images : Dynex (en haut) et Semelab (en bas)



# Sommaire

Introduction

Petit lexique du packaging de puissance

**Considérations physiques**

**Aspects thermiques**

**Aspects thermo-mécaniques**

**Aspects électriques**

Éléments de technologie

Substrats

Interconnexions

Gestion thermique

Évolutions, Recherche et Développement

# Limites thermiques : composants à semiconducteurs

Quelques limites :

1414 °C fusion du silicium

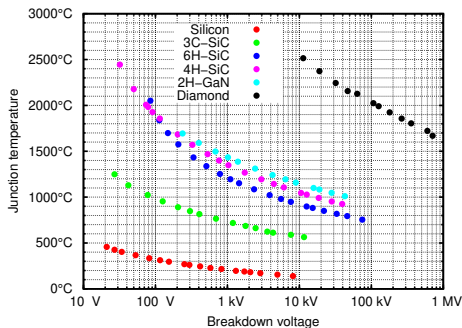
660 °C fusion de l'aluminium

≈ 300 °C fusion de la brasure  
de puce

183 °C fusion de 63Sn37Pb

>200 °C limite de tenue en  
tension (1 kV)

- ▶ De nombreux composants (MOSFETs, diodes) sont moins performants lorsque la température augmente.
- ▶ Les fortes variations de température posent des problèmes de fiabilité.



# Limites thermiques : composants à semiconducteurs

Quelques limites :

1414 °C fusion du silicium

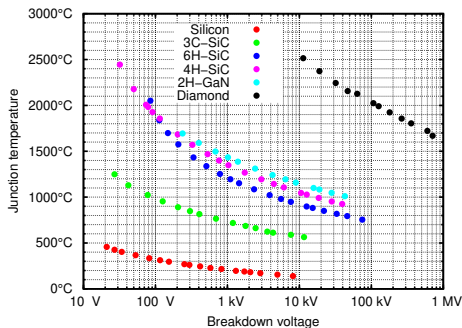
660 °C fusion de l'aluminium

≈ 300 °C fusion de la brasure  
de puce

183 °C fusion de 63Sn37Pb

>200 °C limite de tenue en  
tension (1 kV)

- ▶ De nombreux composants (MOSFETs, diodes) sont moins performants lorsque la température augmente.
- ▶ Les fortes variations de température posent des problèmes de fiabilité.



# Limites thermiques : composants à semiconducteurs

Quelques limites :

1414 °C fusion du silicium

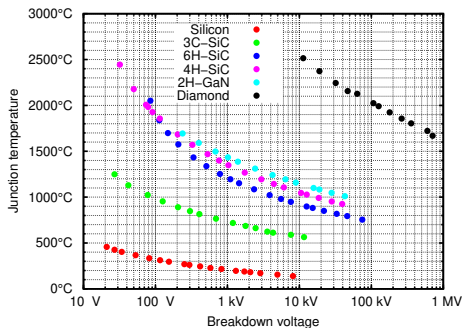
660 °C fusion de l'aluminium

≈ 300 °C fusion de la brasure  
de puce

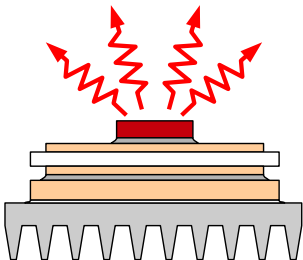
183 °C fusion de 63Sn37Pb

>200 °C limite de tenue en  
tension (1 kV)

- ▶ De nombreux composants (MOSFETs, diodes) sont moins performants lorsque la température augmente.
- ▶ Les fortes variations de température posent des problèmes de fiabilité.



# Mécanismes de transport de la chaleur



## ► Rayonnement

- Loi de Stefan-Boltzmann :  $P = \varepsilon S \sigma T^4$   
avec  $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$  et  $\varepsilon < 1$
- à 400 K,  $P=0,15 \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$
- **Négligeable pour les dimensions et températures classiques de l'électronique**

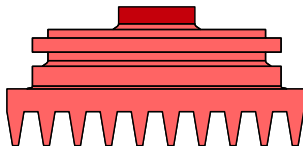
## ► Conduction

- transfert de chaleur dans la matière
- $P = -\frac{\lambda S}{e} \Delta T$ ,  $\lambda = 20 \dots 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Pour une piste en cuivre avec  $e=100 \mu\text{m}$ ,  $S=1 \text{ cm}^2$  et  $\Delta T=1 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $P=400 \text{ W}$

## ► Convection

- Déplacement de matière
- Pas d'expression simple (convection forcée, naturelle, type d'écoulements. . .)

# Mécanismes de transport de la chaleur



## ► Rayonnement

- Loi de Stefan-Boltzmann :  $P = \varepsilon S \sigma T^4$   
avec  $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$  et  $\varepsilon < 1$
- à 400 K,  $P = 0,15 \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$
- Négligeable pour les dimensions et températures classiques de l'électronique

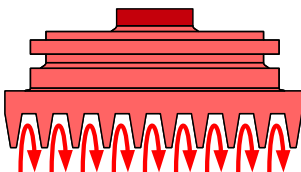
## ► Conduction

- transfert de chaleur dans la matière
- $P = -\frac{\lambda S}{e} \Delta T$ ,  $\lambda = 20 \dots 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Pour une piste en cuivre avec  $e = 100 \mu\text{m}$ ,  $S = 1 \text{ cm}^2$  et  $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $P = 400 \text{ W}$

## ► Convection

- Déplacement de matière
- Pas d'expression simple (convection forcée, naturelle, type d'écoulements. . .)

# Mécanismes de transport de la chaleur



## ► Rayonnement

- Loi de Stefan-Boltzmann :  $P = \varepsilon S \sigma T^4$   
avec  $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$  et  $\varepsilon < 1$
- à 400 K,  $P=0,15 \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$
- Négligeable pour les dimensions et températures classiques de l'électronique

## ► Conduction

- transfert de chaleur dans la matière
- $P = -\frac{\lambda S}{e} \Delta T$ ,  $\lambda = 20 \dots 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Pour une piste en cuivre avec  $e=100 \mu\text{m}$ ,  
 $S=1 \text{ cm}^2$  et  $\Delta T=1 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $P=400 \text{ W}$

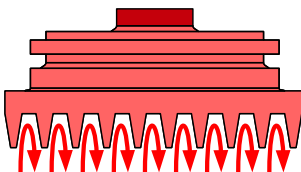
## ► Convection

- Déplacement de matière
- Pas d'expression simple (convection forcée, naturelle, type d'écoulements...)

# Mécanismes de transport de la chaleur

## ► Rayonnement

- Loi de Stefan-Boltzmann :  $P = \varepsilon S \sigma T^4$   
avec  $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$  et  $\varepsilon < 1$
- à 400 K,  $P = 0,15 \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$
- Négligeable pour les dimensions et températures classiques de l'électronique



## ► Conduction

- transfert de chaleur dans la matière
- $P = -\frac{\lambda S}{e} \Delta T$ ,  $\lambda = 20 \dots 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Pour une piste en cuivre avec  $e = 100 \mu\text{m}$ ,  $S = 1 \text{ cm}^2$  et  $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $P = 400 \text{ W}$

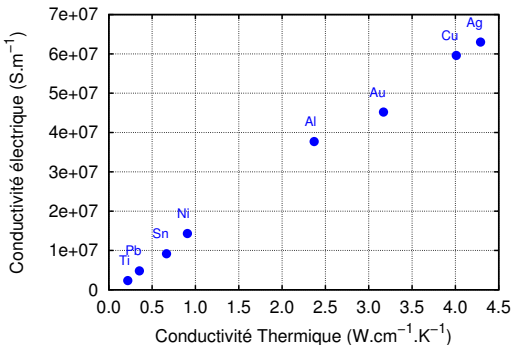
## ► Convection

- Déplacement de matière
- Pas d'expression simple (convection forcée, naturelle, type d'écoulements...)

La gestion thermique en électronique repose sur deux mécanismes : conduction et convection



# Relation entre conductivités thermique et électrique



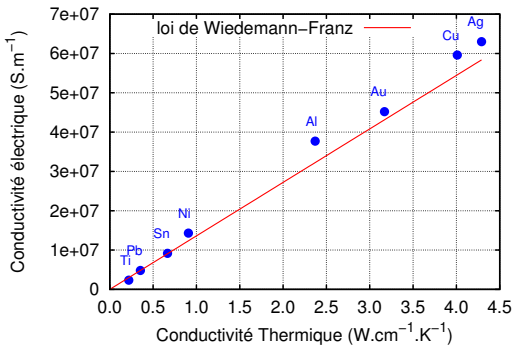
cond. thermique  $\lambda = \lambda_e + \lambda_p$

▶  $\lambda_e$  : porteurs de charges (électrons)

$$\lambda_e = LT\sigma$$

▶  $\lambda_p$  : phonons (vibrations réseau atomique)

# Relation entre conductivités thermique et électrique



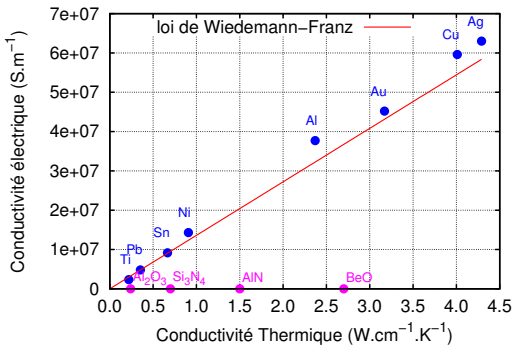
cond. thermique  $\lambda = \lambda_e + \lambda_p$

►  $\lambda_e$  : porteurs de charges (électrons)

$$\lambda_e = LT\sigma$$

►  $\lambda_p$  : phonons (vibrations réseau atomique)

# Relation entre conductivités thermique et électrique



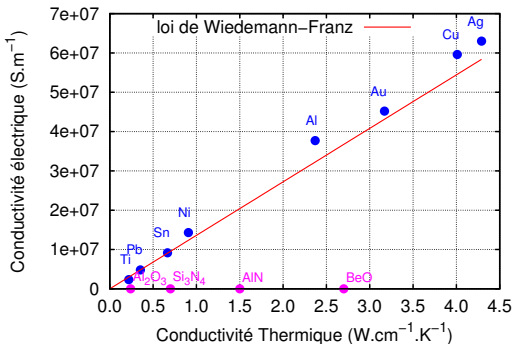
cond. thermique  $\lambda = \lambda_e + \lambda_p$

►  $\lambda_e$  : porteurs de charges (électrons)

$$\lambda_e = LT\sigma$$

►  $\lambda_p$  : phonons (vibrations réseau atomique)

# Relation entre conductivités thermique et électrique



cond. thermique  $\lambda = \lambda_e + \lambda_p$

►  $\lambda_e$  : porteurs de charges (électrons)

$$\lambda_e = LT\sigma$$

►  $\lambda_p$  : phonons (vibrations réseau atomique)

→ Les matériaux bons conducteurs thermiques/isolants électriques sont rares (diamant, AlN, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

# Isolants/conducteurs électrique/thermique

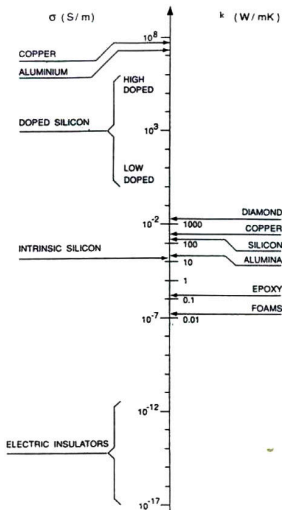
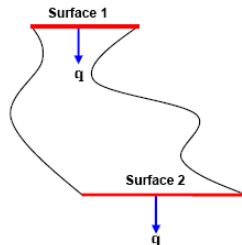


Figure 1: Comparison between electrical and thermal conductivities

Source : Heat Spreading : not a trivial issue, C. Lansance, ECPE Workshop on advanced cooling, 20–21 November, Delft.

- ▶ la conductivité électrique peut varier de plus de 20 décades
  - ▶ le courant passe dans les conducteurs et pas à côté !
  - ▶ La représentation circuit est bien adaptée
- ▶ Pour la conductivité thermique, c'est 4 à 5 décades
  - ▶ Approximation circuit utilisable avec précautions

# Représentation circuit thermique

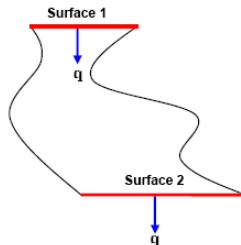


Source : Heat Spreading : not a trivial issue, C. Lansance,  
ECPE Workshop on advanced cooling, 20–21 November, Delft.

On peut définir une  $R_{Th}$  entre 1 et 2 si :

- ▶ Les surfaces 1 et 2 sont isothermes
- ▶ Un flux thermique identique traverse les deux surfaces (conservation)

# Représentation circuit thermique



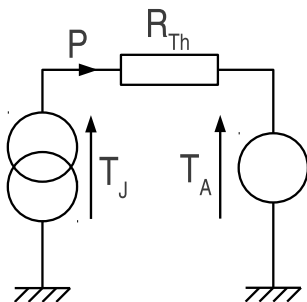
Source : Heat Spreading : not a trivial issue, C. Lansance, ECPE Workshop on advanced cooling, 20-21 November, Delft.

On peut définir une  $R_{Th}$  entre 1 et 2 si :

- ▶ Les surfaces 1 et 2 sont isothermes
- ▶ Un flux thermique identique traverse les deux surfaces (conservation)

On peut alors définir une représentation circuit

- ▶ Les températures sont des efforts (tensions)
- ▶ Les puissances dissipées des flux (courants)
- ▶  $T_J = T_A + R_{Th} \times P$



# Équation de la chaleur

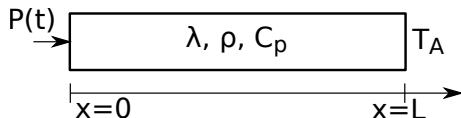
Équation de la chaleur 1-D :

$$\rho C_p \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2}$$

Conditions aux limites :

$$S \cdot \lambda \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = -P(t)$$

$$T(t, x = L) = T_a$$



- ▶  $S$  section du barreau ( $m^2$ )
- ▶  $C_p$  chaleur spécifique ( $J/K/kg$ )
- ▶  $\rho$  densité ( $kg/m^3$ )



# Équation de la chaleur

Équation de la chaleur 1-D :

$$\rho C_p \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2}$$

Conditions aux limites :

$$S \cdot \lambda \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = -P(t)$$

$$T(t, x = L) = T_a$$

Discrétisation de l'équation :

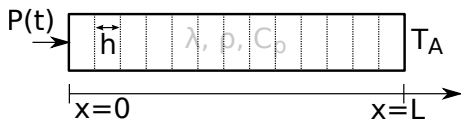
$$\rho C_p \frac{\partial T_i(t)}{\partial t} = \lambda \frac{T_{i+1}(t) + T_{i-1}(t) - 2T_i(t)}{h^2}$$

$$h S \rho C_p \frac{\partial T_i(t)}{\partial t} = \lambda S \frac{T_{i+1}(t) - T_i(t)}{h} - \lambda S \frac{T_i(t) - T_{i-1}(t)}{h}$$



- ▶  $S$  section du barreau ( $m^2$ )
- ▶  $C_p$  chaleur spécifique ( $J/K/kg$ )
- ▶  $\rho$  densité ( $kg/m^3$ )

# Équation de la chaleur – suite

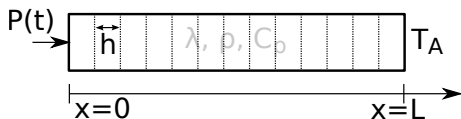


$$hS\rho C_p \frac{\partial T_i(t)}{\partial t} = \lambda S \frac{T_{i+1}(t) - T_i(t)}{h} - \lambda S \frac{T_i(t) - T_{i-1}(t)}{h}$$

On pose  $hS\rho C_p = C_{Th}$  et  $\frac{h}{\lambda S} = R_{Th}$  d'où :

$$C_{Th} \frac{\partial T_i(t)}{\partial t} = \frac{T_{i+1}(t) - T_i(t)}{R_{Th}} - \frac{T_i(t) - T_{i-1}(t)}{R_{Th}}$$

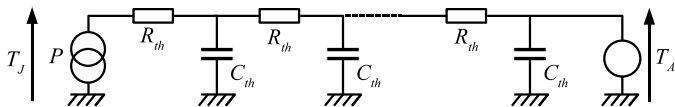
# Équation de la chaleur – suite



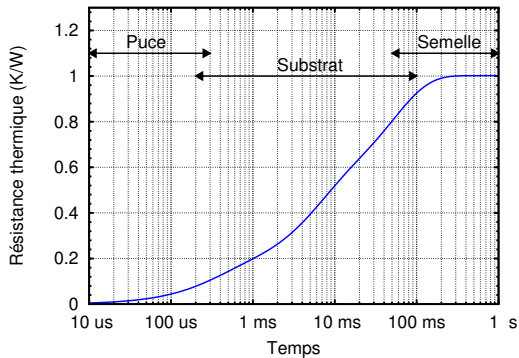
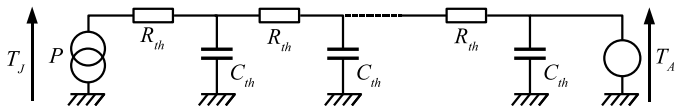
$$hS\rho C_p \frac{\partial T_i(t)}{\partial t} = \lambda S \frac{T_{i+1}(t) - T_i(t)}{h} - \lambda S \frac{T_i(t) - T_{i-1}(t)}{h}$$

On pose  $hS\rho C_p = C_{Th}$  et  $\frac{h}{\lambda S} = R_{Th}$  d'où :

$$C_{Th} \frac{\partial T_i(t)}{\partial t} = \frac{T_{i+1}(t) - T_i(t)}{R_{Th}} - \frac{T_i(t) - T_{i-1}(t)}{R_{Th}}$$



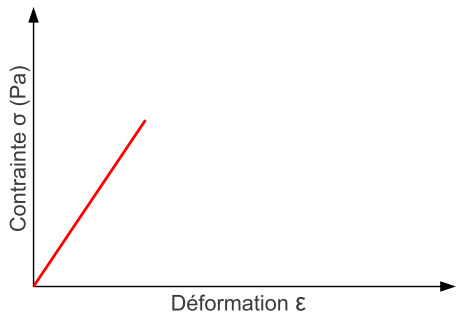
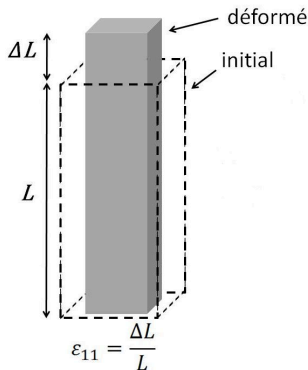
# Impédance thermique



Extension au régime dynamique :

- ▶ mêmes conditions (conservation du flux, surfaces isothermes)
- ▶ aux courtes échelles de temps, fonctionnement propagatif

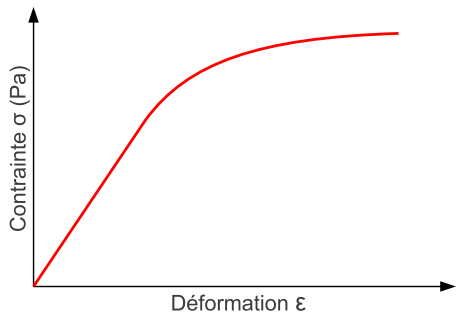
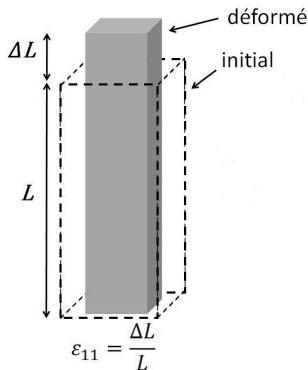
# Un peu de mécanique...



Source : thèse L. Pietranico, <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543040/fr/>

- ▶ Déformation élastique (réversible)
- ▶ Déformation plastique (irréversible)
- ▶ Apparition d'une déformation résiduelle
- ▶ accumulation de la déformation menant à la rupture

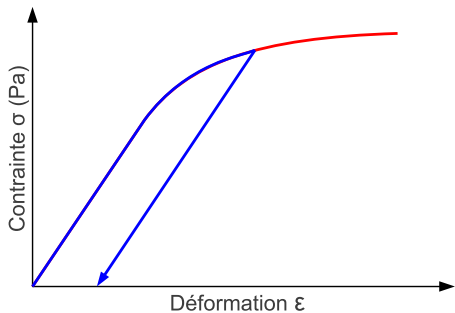
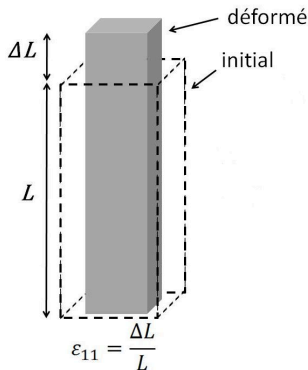
# Un peu de mécanique...



Source : thèse L. Pietranico, <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543040/fr/>

- ▶ Déformation élastique (réversible)
- ▶ Déformation plastique (irréversible)
- ▶ Apparition d'une déformation résiduelle
- ▶ accumulation de la déformation menant à la rupture

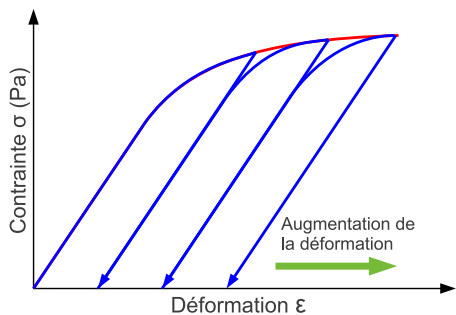
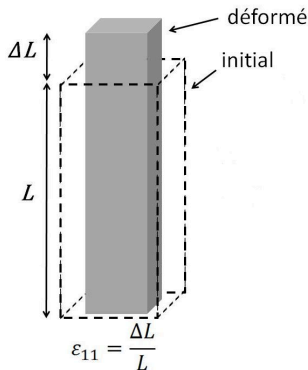
# Un peu de mécanique...



Source : thèse L. Pietranico, <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543040/fr/>

- ▶ Déformation élastique (réversible)
- ▶ Déformation plastique (irréversible)
- ▶ Apparition d'une déformation résiduelle
- ▶ accumulation de la déformation menant à la rupture

# Un peu de mécanique...

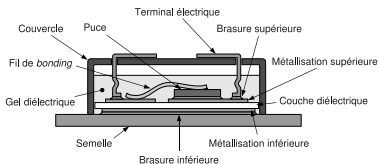


Source : thèse L. Pietranico, <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543040/fr/>

- ▶ Déformation élastique (réversible)
- ▶ Déformation plastique (irréversible)
- ▶ Apparition d'une déformation résiduelle
- ▶ accumulation de la déformation menant à la rupture

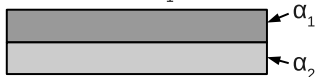


# Effet des coefficients de dilatation

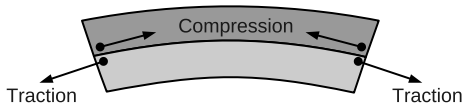


- ▶  $\alpha$  en ppm/K
- ▶  $3.10^{-6} < \alpha < 20.10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

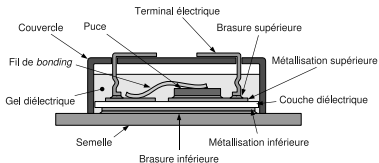
Température de repos  $T_1$



$T_2 > T_1$

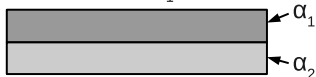


# Effet des coefficients de dilatation



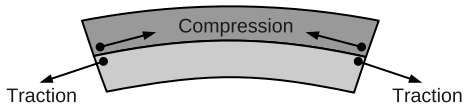
- ▶  $\alpha$  en ppm/K
- ▶  $3.10^{-6} < \alpha < 20.10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

Température de repos  $T_1$

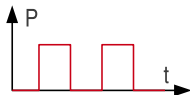


$$\alpha_1 > \alpha_2$$

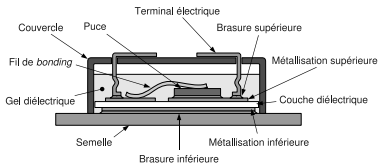
$T_2 > T_1$



Fonctionnement  
cyclique

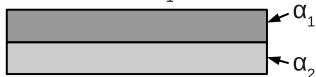


# Effet des coefficients de dilatation

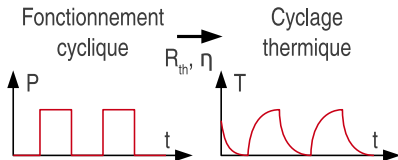
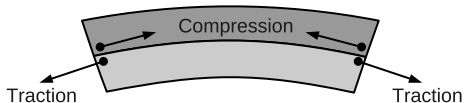


- ▶  $\alpha$  en ppm/K
- ▶  $3 \cdot 10^{-6} < \alpha < 20 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

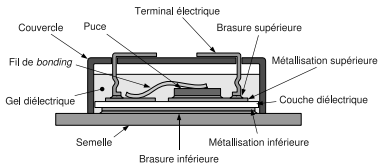
Température de repos  $T_1$



$T_2 > T_1$

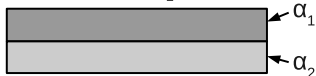


# Effet des coefficients de dilatation

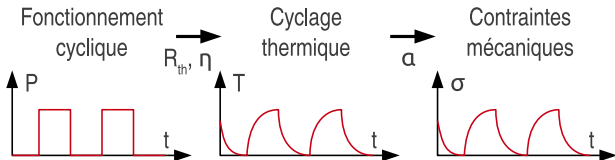
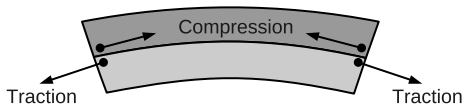


- ▶  $\alpha$  en ppm/K
- ▶  $3 \cdot 10^{-6} < \alpha < 20 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

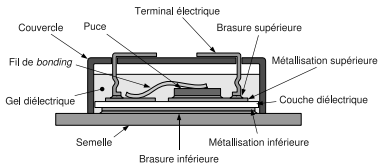
Température de repos  $T_1$



$T_2 > T_1$

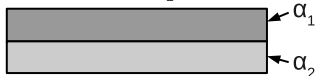


# Effet des coefficients de dilatation

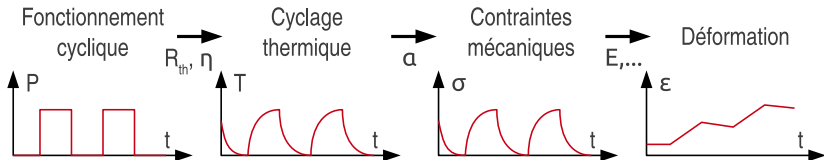
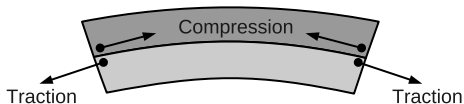


- ▶  $\alpha$  en ppm/K
- ▶  $3 \cdot 10^{-6} < \alpha < 20 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

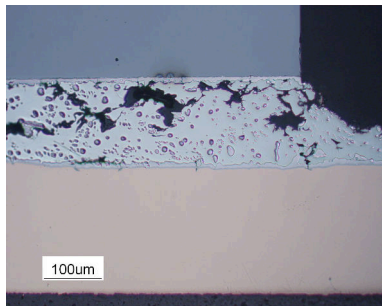
Température de repos  $T_1$



$T_2 > T_1$



# Effet des contraintes thermo-mécaniques

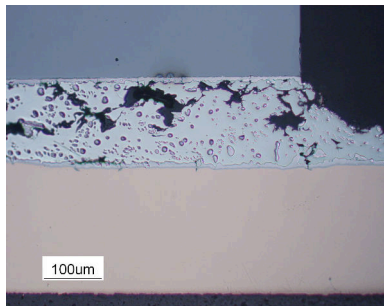


Source : Université de Nottingham

## Brasure puce-substrat

- ▶ Puce en silicium (3 ppm/K)
- ▶ Conducteur en cuivre (17 ppm/K)
- ▶ Brasure tendre concentrant la fatigue

# Effet des contraintes thermo-mécaniques



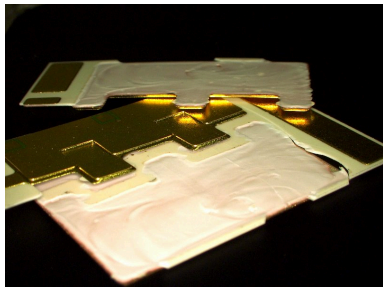
Source : Université de Nottingham

## Brasure puce-substrat

- ▶ Puce en silicium (3 ppm/K)
- ▶ Conducteur en cuivre (17 ppm/K)
- ▶ Brasure tendre concentrant la fatigue

## Substrat céramique métallisé

- ▶ Conducteur en cuivre (17 ppm/K)
- ▶ Substrat céramique (6 ppm/K)
- ▶ Fissuration « conchoïdale » de la céramique



Source : Université de Nottingham

# Aspects électriques

- ▶ Tout conducteur constitue une résistance, une inductance, et l'armature d'un condensateur
- ▶ Suivant les gammes de courant/tension certains éléments sont prépondérants
- ▶ Une modélisation fine peut être nécessaire (PEEC, EF)
- ▶ Faute de temps, nous n'irons pas plus loin ici !



# Sommaire

Introduction

Petit lexique du packaging de puissance

Considérations physiques

Aspects thermiques

Aspects thermo-mécaniques

Aspects électriques

**Éléments de technologie**

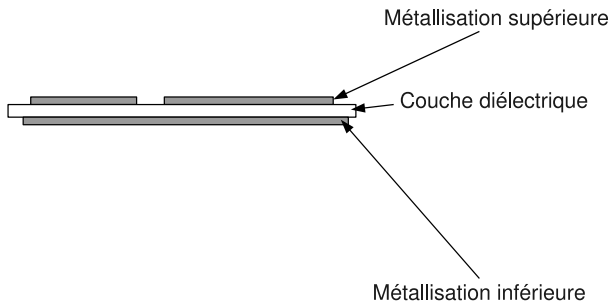
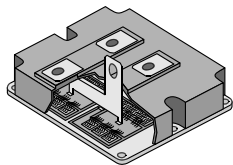
**Substrats**

**Interconnexions**

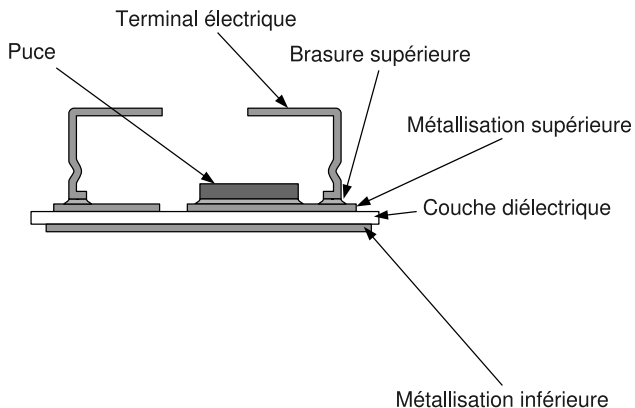
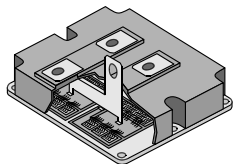
**Gestion thermique**

Évolutions, Recherche et Développement

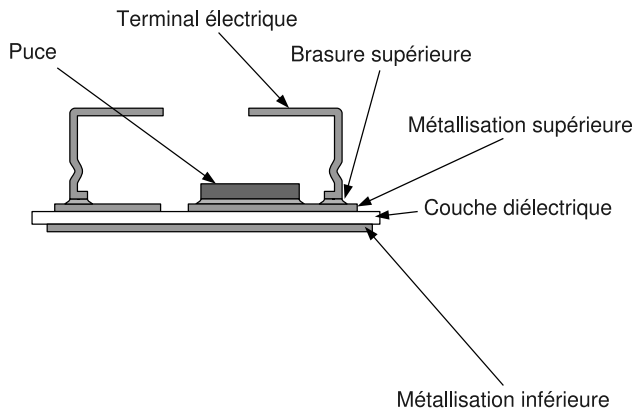
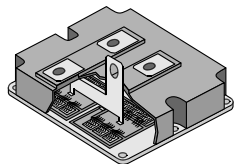
# Coupe d'un module de puissance



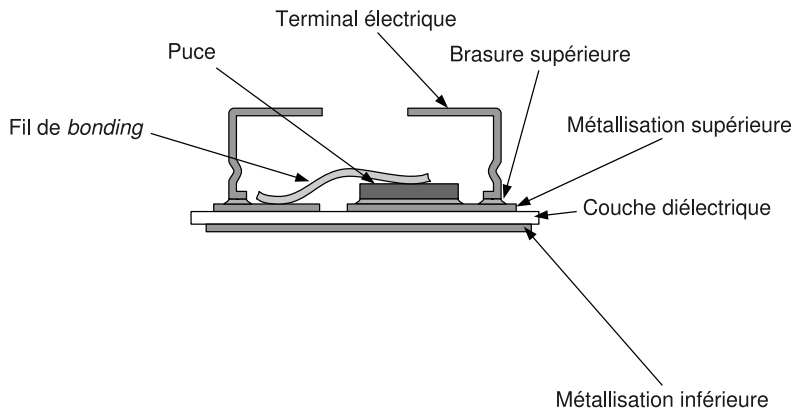
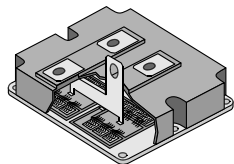
# Coupe d'un module de puissance



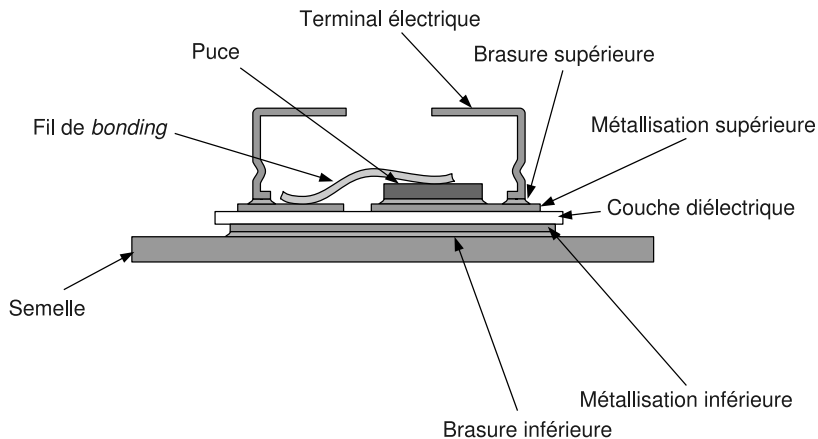
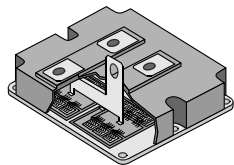
# Coupe d'un module de puissance



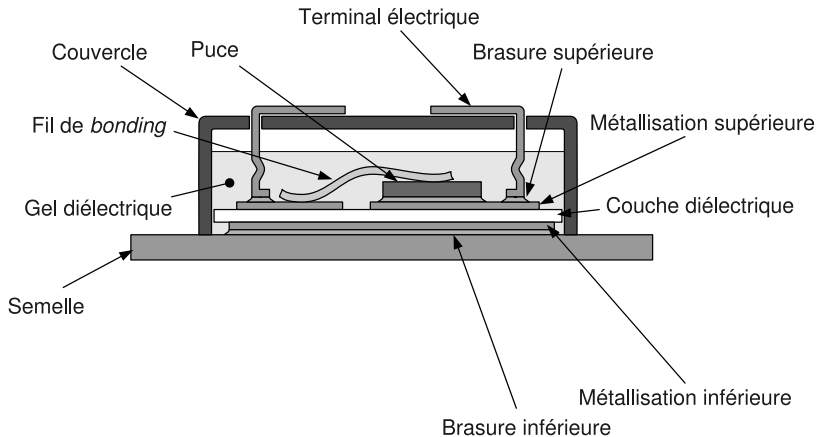
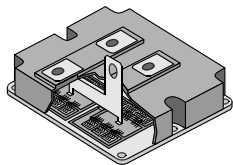
# Coupe d'un module de puissance



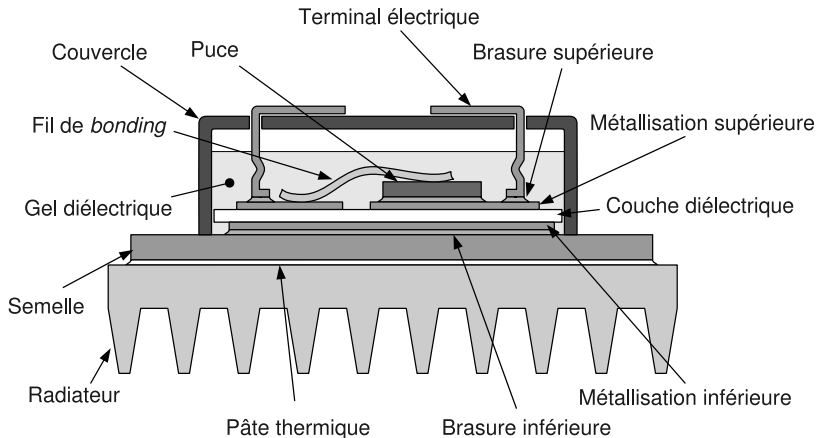
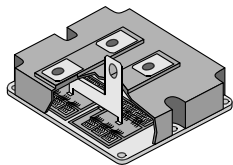
# Coupe d'un module de puissance



# Coupe d'un module de puissance

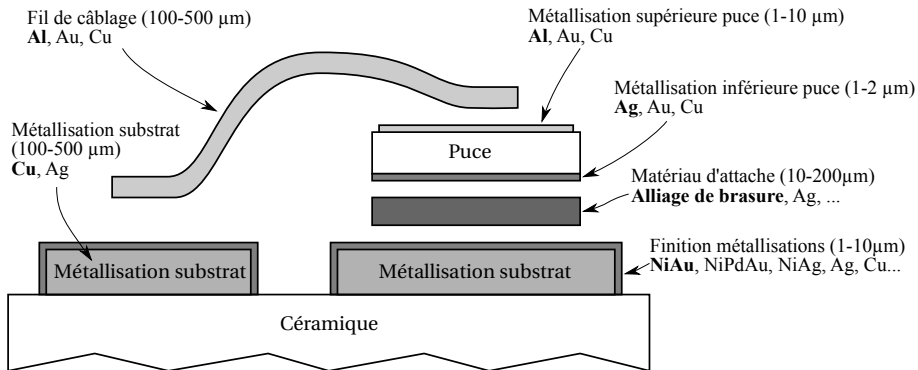


# Coupe d'un module de puissance





# Finitions métalliques du packaging

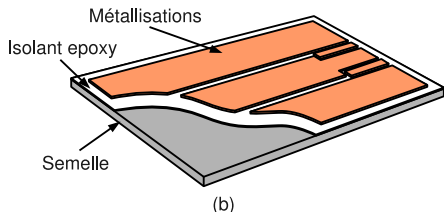
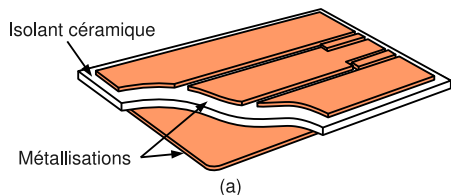


**En gras :** les finitions et métaux les plus courants

Ces finitions visent à :

- ▶ protéger de l'oxydation, la diffusion d'espèces chimiques ;
- ▶ la compatibilité avec les procédés d'interconnexion.

# Substrats isolés



Plusieurs technologies :

▶ Les substrats céramiques (DBC, DBA, ...)

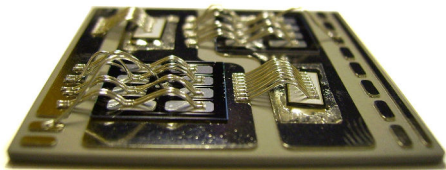
- ▶ céramique (0,3 à 1 mm)
- ▶ cuivre (0,1 à 0,3 mm)
- ▶ Bonnes performances thermiques et électriques
- ▶ Cher

▶ Les Substrats Métalliques Isolés (SMI)

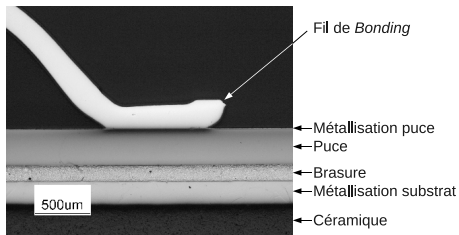
- ▶ aluminium (1 à 3 mm)
- ▶ isolant (0,1 mm)
- ▶ cuivre (0,035 à 0,2 mm)
- ▶ Performances moyennes
- ▶ Coef. de dilatation plus fort
- ▶ Moins cher

# Fils de *bonding*

- ▶ Fils épais (100 à 400  $\mu m$ ), en aluminium
- ▶ Mise en parallèle pour réduire la résistance
- ▶ Soudure ultrasonique (faible échauffement)
- ▶ Évolutions vers les fils de cuivre, les rubans. . .



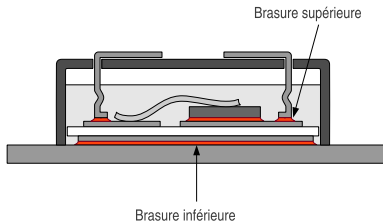
Source : Université Nottingham



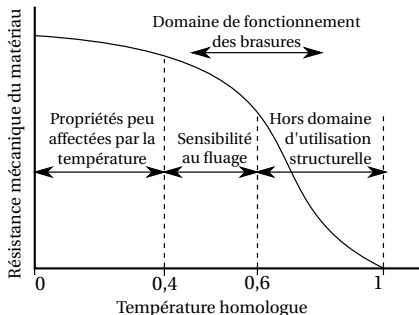
Source : Université Nottingham

# Les brasures

- ▶ Brasures réalisées au four
- ▶ Utilisation de pâte à braser, de preforms
- ▶ Nombreux alliages disponibles
- ▶ Tendance au “sans plomb” (RoHS)
- ▶ Habituellement deux étapes de brasure :
  - ▶ puces et connecteurs sur substrat
  - ▶ substrat sur semelle



# Les brasures – limites de fonctionnement



Source : [http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0123\\_mpm/](http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0123_mpm/)

- ▶ Les propriétés mécaniques diminuent avec la température
- ▶ Plus aucune tenue à la température de fusion ( $T_M$ )

▶ Température homologue :

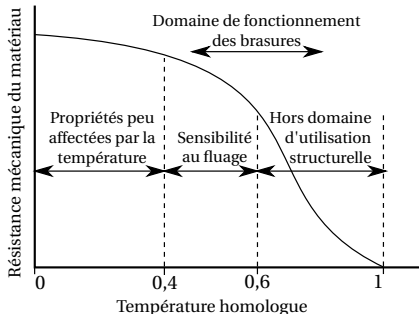
$$T_H = \frac{T_O[K]}{T_M[K]}$$

▶ Limite de fonctionnent fiable des brasures basse

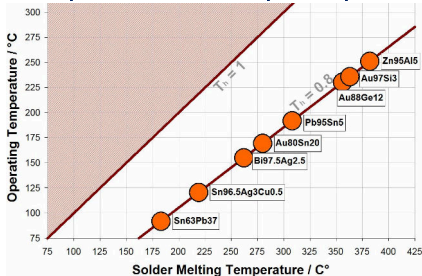
▶ ex :  $T_M=300^\circ\text{C}$  (573 K), pour  $T_H=0.8$  :  $T_O=185^\circ\text{C}$

▶ ex :  $T_M=183^\circ\text{C}$  (fil de brasure standard), pour  $T_H=0.8$  :  $T_O=92^\circ\text{C}$

# Les brasures – limites de fonctionnement



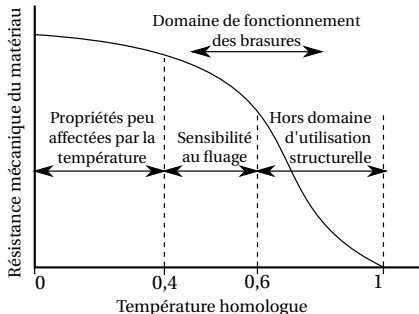
Source : [http://www.am1.ac.uk/courses/topics/0123\\_mpm/](http://www.am1.ac.uk/courses/topics/0123_mpm/)



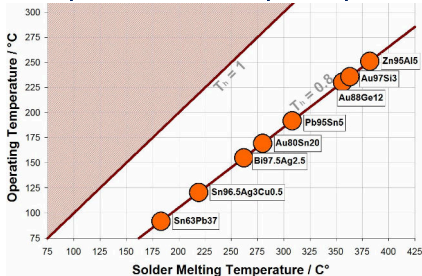
Source : Power Semiconductor Joining through Sintering of Silver Nanoparticles...  
M.Knoerr et al, CIPS 2010

- ▶ Les propriétés mécaniques diminuent avec la température
- ▶ Plus aucune tenue à la température de fusion ( $T_M$ )
- ▶ Température homologue : 
$$T_H = \frac{T_O[K]}{T_M[K]}$$
- ▶ Limite de fonctionnent fiable des brasures basse
  - ▶ ex :  $T_M=300\text{ °C}$  (573 K), pour  $T_H=0.8$  :  $T_O=185\text{ °C}$
  - ▶ ex :  $T_M=183\text{ °C}$  (fil de brasure standard), pour  $T_H=0.8$  :  $T_O=92\text{ °C}$

# Les brasures – limites de fonctionnement



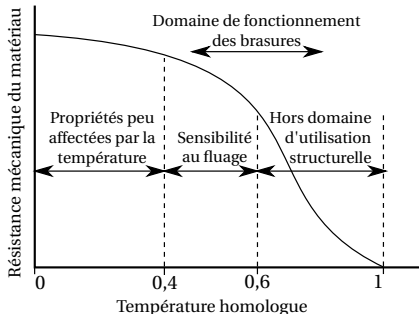
Source : [http://www.am1.ac.uk/courses/topics/0123\\_mpm/](http://www.am1.ac.uk/courses/topics/0123_mpm/)



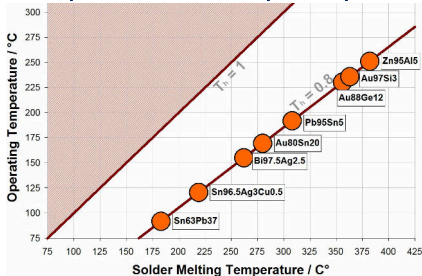
Source : Power Semiconductor Joining through Sintering of Silver Nanoparticles...  
M.Knoerr et al, CIPS 2010

- ▶ Les propriétés mécaniques diminuent avec la température
- ▶ Plus aucune tenue à la température de fusion ( $T_M$ )
- ▶ Température homologue : 
$$T_H = \frac{T_O[K]}{T_M[K]}$$
- ▶ Limite de fonctionnent fiable des brasures basse
- ▶ ex :  $T_M=300\text{ °C}$  (573 K), pour  $T_H=0.8$  :  $T_O=185\text{ °C}$
- ▶ ex :  $T_M=183\text{ °C}$  (fil de brasure standard), pour  $T_H=0.8$  :  $T_O=92\text{ °C}$

# Les brasures – limites de fonctionnement



Source : [http://www.am1.ac.uk/courses/topics/0123\\_mpm/](http://www.am1.ac.uk/courses/topics/0123_mpm/)



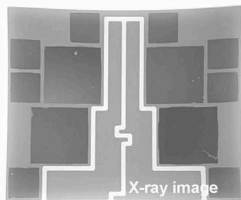
Source : Power Semiconductor Joining through Sintering of Silver Nanoparticles...  
M.Knoerr et al, CIPS 2010

- ▶ Les propriétés mécaniques diminuent avec la température
- ▶ Plus aucune tenue à la température de fusion ( $T_M$ )
- ▶ Température homologue : 
$$T_H = \frac{T_O[K]}{T_M[K]}$$
- ▶ Limite de fonctionnement fiable des brasures basse
- ▶ ex :  $T_M=300\text{ °C}$  (573 K), pour  $T_H=0.8$  :  $T_O=185\text{ °C}$
- ▶ ex :  $T_M=183\text{ °C}$  (fil de brasure standard), pour  $T_H=0.8$  :  $T_O=92\text{ °C}$

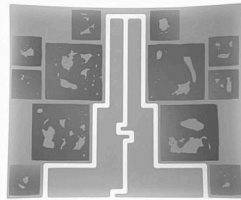


# Les brasures – problème des vides

## Formic Acid atmosphere prior reflow versus non



Formic Acid atmosphere prior reflow



non Formic Acid atmosphere

void free solder joints even without vacuum prior and during reflow

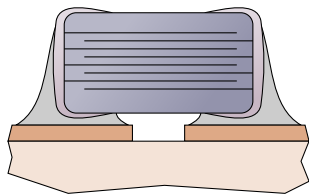
Source : Reflow Soldering Technology for large die area Power Electronics, Matthias Hutter, Microcar, Leipzig, 21 juin 2005

risque de vides sur les brasures de grande surface :

- ▶ augmentation de la résistance thermique
- ▶ apparition de points chauds
- ▶ peut être réduit par utilisation d'atmosphères spécifiques durant le process (vide, gaz actifs. . .)

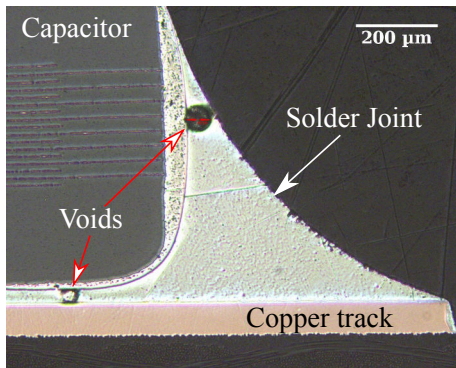
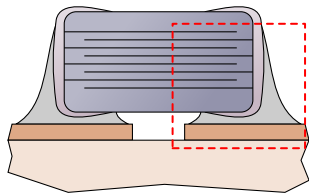
# Vieillesse de brasures [1] (Ampère/IMS) – 1

- ▶ Vacuoles dans le joint dès le début
- ▶ Après cyclage (750 cycles) :
  - ▶ Plus de vacuoles
  - ▶ Amorce de fissuration
  - ▶ Rugosification de surface



# Vieillessement de brasures [1] (Ampère/IMS) – 1

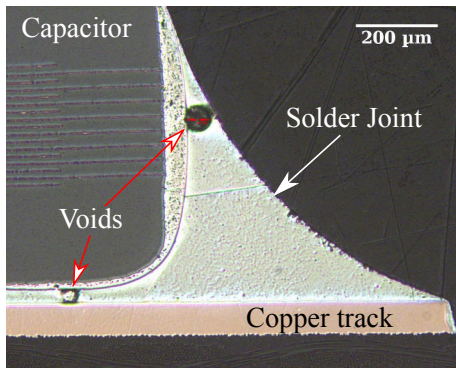
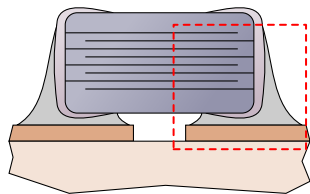
- ▶ Vacuoles dans le joint dès le début
- ▶ Après cyclage (750 cycles) :
  - ▶ Plus de vacuoles
  - ▶ Amorce de fissuration
  - ▶ Rugosification de surface



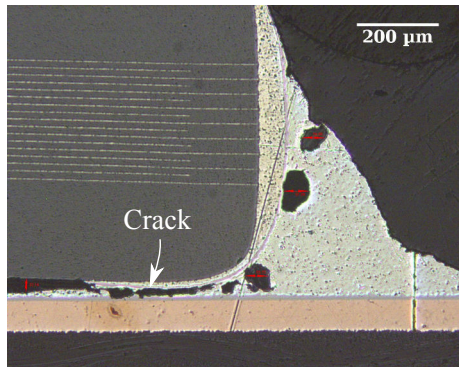
$t=0$

# Vieillessement de brasures [1] (Ampère/IMS) – 1

- ▶ Vacuoles dans le joint dès le début
- ▶ Après cyclage (750 cycles) :
  - ▶ Plus de vacuoles
  - ▶ Amorce de fissuration
  - ▶ Rugosification de surface

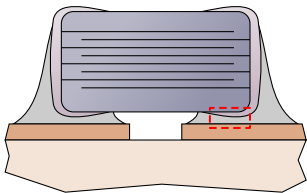


$t=0$



750 cycles (-55/+175 °C)

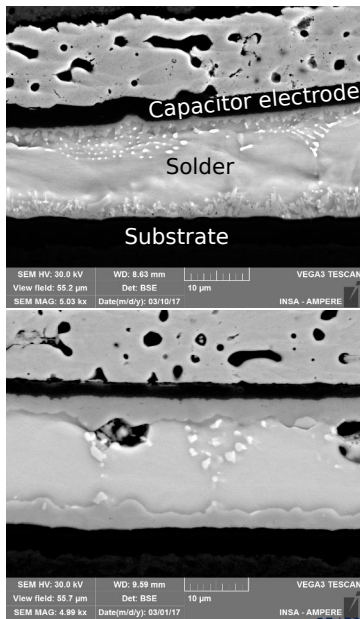
# Vieillessement de brasures [1] (Ampère/IMS) – 2



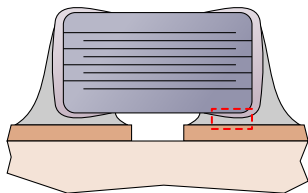
## Stockage 175 °C, 310 h

- ▶ Les IMC interfaciaux sont continus
- ▶ Pas de fissuration

Haut droit : stockage, bas droit : stockage.



# Vieillessement de brasures [1] (Ampère/IMS) – 2



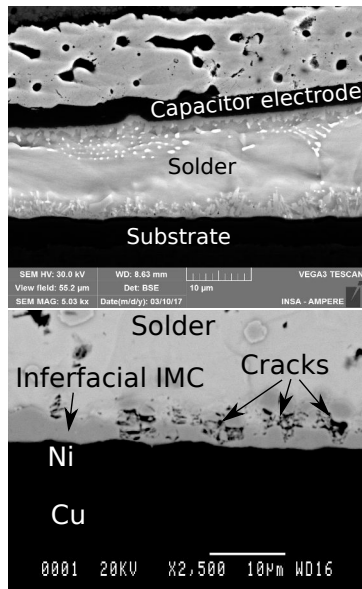
## Stockage 175 °C, 310 h

- ▶ Les IMC interfaciaux sont continus
- ▶ Pas de fissuration

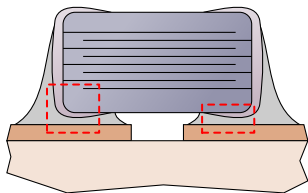
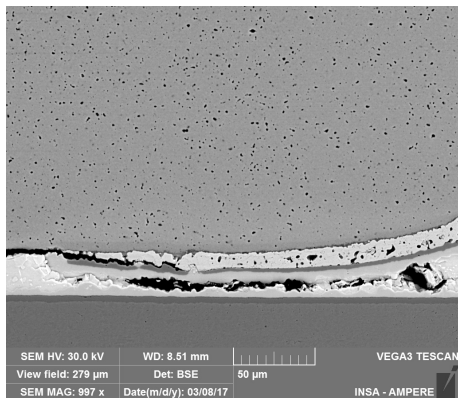
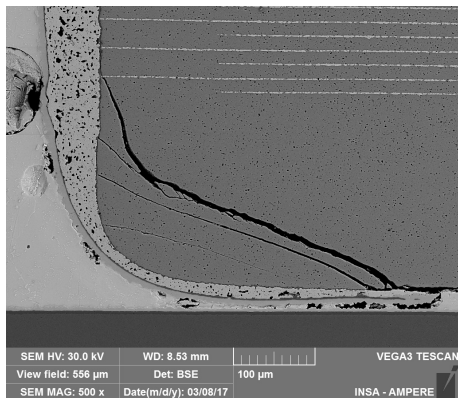
## Cyclage -55/+175 °C, 1500 cycles

- ▶ Les IMC interfaciaux sont continus
- ▶ Fissures entre les IMC et la brasure

Haut droit : stockage, bas droit : cyclage.



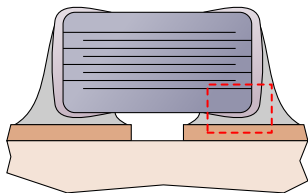
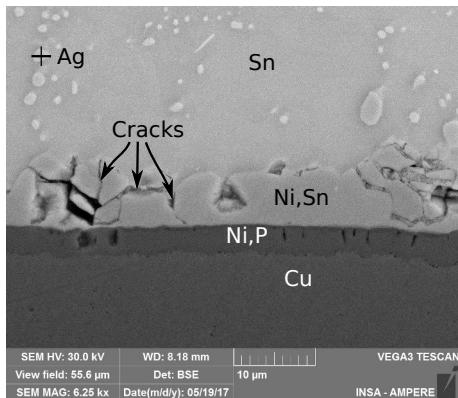
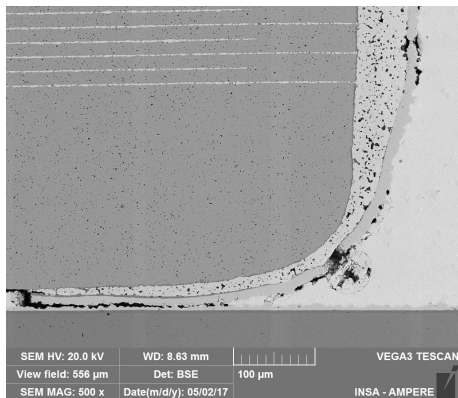
# Vieillesse de brasures [1] (Ampère/IMS) – 3



**stockage 175 °C, 1000 h**

- ▶ Les IMC interfaciaux s'épaississent
- ▶ Ils prennent tout l'espace sous le condensateur
- ▶ Des fissures apparaissent

# Vieillessement de brasures [1] (Ampère/IMS) – 4

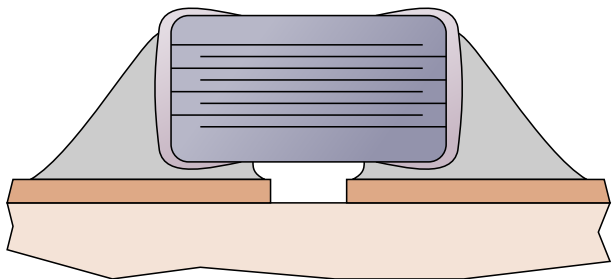


## Stockage 175 °C, 2562 h

- ▶ Les IMC croissent là où c'est possible
- ▶ Les fissures continuent à se propager
- ▶ Elles se produisent aussi dans les IMC



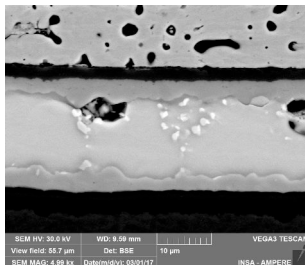
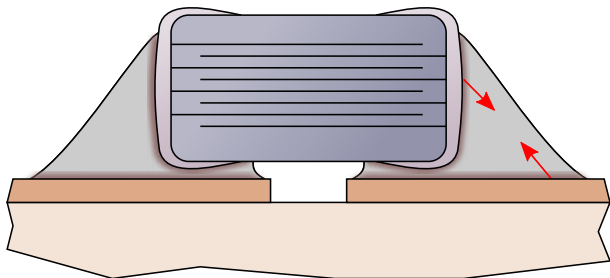
# Vieillessement de brasures [1] (Ampère/IMS) –



## Mécanismes du vieillissement isotherme :

- ▶ Les IMC interfaciaux croissent
  - ▶ IMC plus denses que la brasure → le joint se contracte
  - ▶ Augmentation des contraintes résiduelles dans le joint
- ▶ Au cours de la croissance des IMC
  - ▶ Des fissures se propagent à l'interface IMC/brasure
  - ▶ Peuvent également se propager dans le condensateur
- ▶ **Test caricatural**
  - ▶ la brasure SAC305 fond à 217 °C, le test est réalisé à 175 °C
  - ▶ 100 cycles profonds accélère la dégradation

# Vieillessement de brasures [1] (Ampère/IMS) –



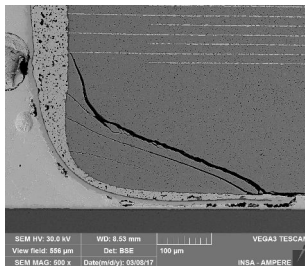
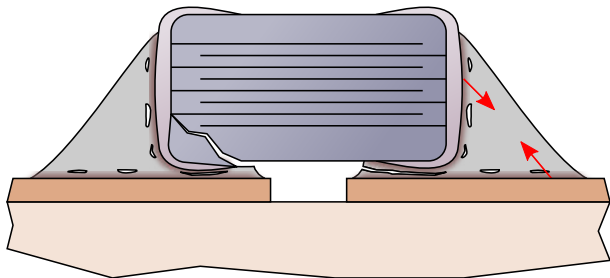
## Mécanismes du vieillissement isotherme :

- ▶ Les IMC interfaciaux croissent
  - ▶ IMC plus denses que la brasure → le joint se contracte
  - ▶ Augmentation des contraintes résiduelles dans le joint
- ▶ Au cours de la croissance des IMC
  - ▶ Des fissures se propagent à l'interface IMC/brasure
  - ▶ Peuvent également se propager dans le condensateur
- ▶ Test caricatural

→ la brasure SA6305 fond à 217 °C, le test est réalisé à 175 °C

→ la température est maintenue pendant la durée du test

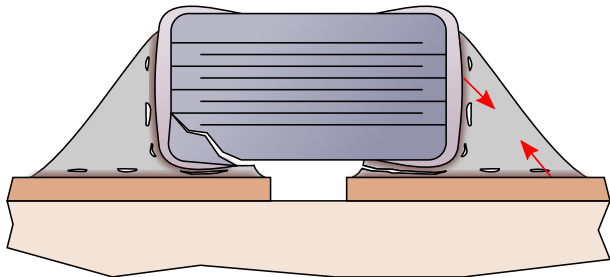
# Vieillessement de brasures [1] (Ampère/IMS) –



## Mécanismes du vieillissement isotherme :

- ▶ Les IMC interfaciaux croissent
  - ▶ IMC plus denses que la brasure → le joint se contracte
  - ▶ Augmentation des contraintes résiduelles dans le joint
- ▶ Au cours de la croissance des IMC
  - ▶ Des fissures se propagent à l'interface IMC/brasure
  - ▶ Peuvent également se propager dans le condensateur
- ▶ Test caricatural

# Vieillessement de brasures [1] (Ampère/IMS) –



## Mécanismes du vieillissement isotherme :

- ▶ Les IMC interfaciaux croissent
  - ▶ IMC plus denses que la brasure → le joint se contracte
  - ▶ Augmentation des contraintes résiduelles dans le joint
- ▶ Au cours de la croissance des IMC
  - ▶ Des fissures se propagent à l'interface IMC/brasure
  - ▶ Peuvent également se propager dans le condensateur
- ▶ **Test caricatural**
  - ▶ la brasure SAC305 fond à 217 °C, le test est réalisé à 175 °C
  - ▶ Le cyclage profond accélère la dégradation.

# Les méthodes alternatives à la brasure

Objectif : décorrélérer  $T_{process}$  and  $T_{fonctionnement}$ .

- ▶ Brasure :  $T_{process} > T_{fusion} > T_{fonctionnement}$  par définition.
- ▶ Frittage :
  - ▶ phénomène de diffusion (habituellement à l'état solide);
  - ▶  $T_{process} < T_{fusion}$ .
- ▶ Soudure en phase liquide transitoire (TLPB, SLID) :
  - ▶ fusion d'un matériau de liaison;
  - ▶ diffusion du liquide dans un matériau solide;
  - ▶ formation d'un nouveau composé à haut point de fusion;
  - ▶  $T_{process} < T_{fusion}$  pour le composé final.

# Les méthodes alternatives à la brasure

Objectif : décorrélérer  $T_{process}$  and  $T_{fonctionnement}$ .

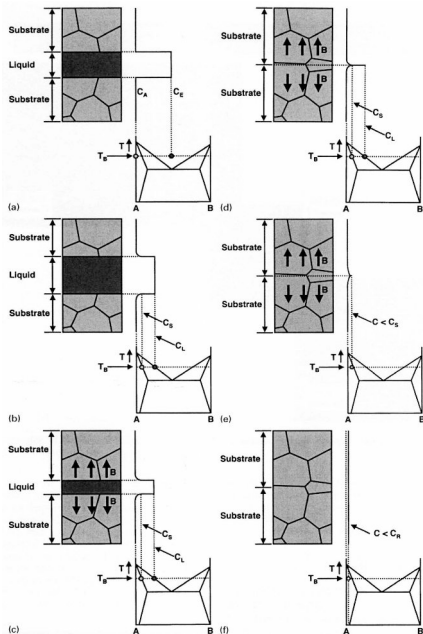
- ▶ Brasure :  $T_{process} > T_{fusion} > T_{fonctionnement}$  par définition.
- ▶ Frittage :
  - ▶ phénomène de diffusion (habituellement à l'état solide) ;
  - ▶  $T_{process} < T_{fusion}$ .
- ▶ Soudure en phase liquide transitoire (TLPB, SLID) :
  - ▶ fusion d'un matériau de liaison ;
  - ▶ diffusion du liquide dans un matériau solide ;
  - ▶ formation d'un nouveau composé à haut point de fusion ;
  - ▶  $T_{process} < T_{fusion}$  pour le composé final.

# Les méthodes alternatives à la brasure

Objectif : décorrélérer  $T_{process}$  and  $T_{fonctionnement}$ .

- ▶ Brasure :  $T_{process} > T_{fusion} > T_{fonctionnement}$  par définition.
- ▶ Frittage :
  - ▶ phénomène de diffusion (habituellement à l'état solide) ;
  - ▶  $T_{process} < T_{fusion}$ .
- ▶ Soudure en phase liquide transitoire (TLPB, SLID) :
  - ▶ fusion d'un matériau de liaison ;
  - ▶ diffusion du liquide dans un matériau solide ;
  - ▶ formation d'un nouveau composé à haut point de fusion ;
  - ▶  $T_{process} < T_{fusion}$  pour le composé final.

# Soudure en phase liquide transitoire



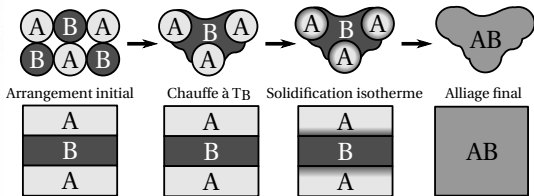
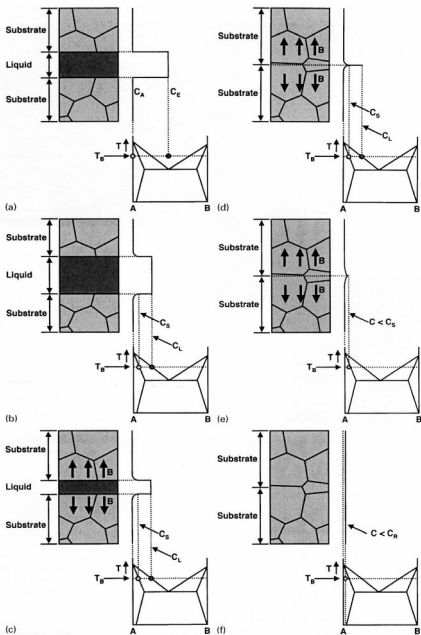
- ▶ Matériau fusible : Sn, In
- ▶ Matériau substrat : Cu, Ag, Au
- ▶ Épaisseurs :
  - ▶ Substrat : dizaines de microns
  - ▶ Couche fusible : microns
- ▶ Alternative : utilisation de poudres
- ▶ Mise au point complexe (IMC)

Source image de gauche : [2] ; image ci-dessus [3]



# Soudure en phase liquide transitoire

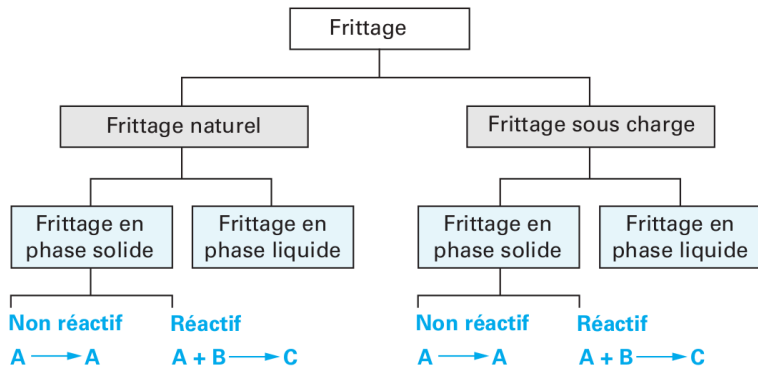
- ▶ Matériau fusible : Sn, In
- ▶ Matériau substrat : Cu, Ag, Au
- ▶ Épaisseurs :
  - ▶ Substrat : dizaines de microns
  - ▶ Couche fusible : microns
- ▶ Alternative : utilisation de poudres
- ▶ Mise au point complexe (IMC)



Source image de gauche : [2]; image ci-dessus [3]



# Le frittage, une alternative à la brasure

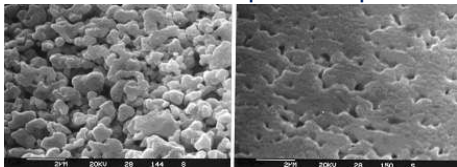


Source : Article Frittage techniques de l'ingénieur [4]

Dans tous les cas, il s'agit de former un **solide** par création de **ponts entre des particules sans atteindre la température de fusion** du constituant principal.

# Attache de puce par frittage d'argent

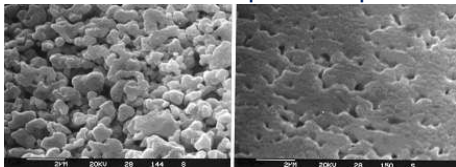
## Densification sans phase liquide



Göbl, C. et al "Low temperature sinter technology Die attachment for automotive power electronic applications" proc of APE, 2006

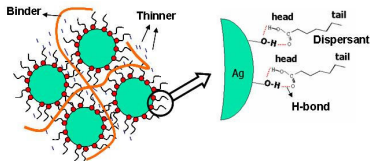
# Attache de puce par frittage d'argent

## Densification sans phase liquide



Göbl, C. et al "Low temperature sinter technology Die attachment for automotive power electronic applications" proc of APE, 2006

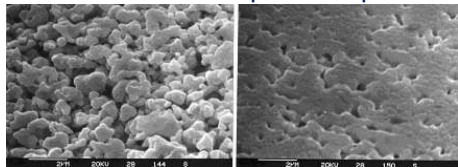
## On rajoute de quoi faire une pâte



Bai, G. "Low-Temperature Sintering of Nanoscale Silver Paste for Semiconductor Device Interconnection" Thèse Virginia Tech., 2005

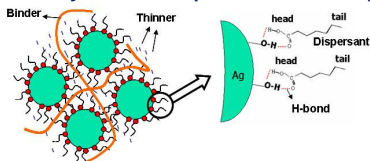
# Attache de puce par frittage d'argent

## Densification sans phase liquide



Göbl, C. et al "Low temperature sinter technology Die attachment for automotive power electronic applications" proc of APE, 2006

## On rajoute de quoi faire une pâte



Bai, G. "Low-Temperature Sintering of Nanoscale Silver Paste for Semiconductor Device Interconnection" Thèse Virginia Tech., 2005

## Les paramètres principaux du procédé

- ▶ La température
- ▶ Le temps
- ▶ La pression

## Mais aussi :

- ▶ Les conditions de séchage
- ▶ Les rampes de montée en température
- ▶ L'atmosphère de frittage
- ▶ La taille de puce
- ▶ ...

# Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
  - ▶ Thermique : 429 W/m.K
  - ▶ Électrique :  $63 \cdot 10^6$  S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
  - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
  - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm<sup>2</sup>.

# Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
  - ▶ Thermique : 429 W/m.K
  - ▶ Électrique :  $63 \cdot 10^6$  S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
  - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
  - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm<sup>2</sup>.

# Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
  - ▶ Thermique : 429 W/m.K
  - ▶ Électrique :  $63 \cdot 10^6$  S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
  - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
  - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm<sup>2</sup>



# Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
  - ▶ Thermique : 429 W/m.K
  - ▶ Électrique :  $63 \cdot 10^6$  S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
  - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
  - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm<sup>2</sup>

# Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
  - ▶ Thermique : 429 W/m.K
  - ▶ Électrique :  $63 \cdot 10^6$  S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
  - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
  - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm<sup>2</sup>.

# Les pâtes/film d'argent



Source : Bai, G. [5]

Deux grandes classes de matériaux :

- ▶ Nanoparticules :

- ▶ Frittage basse ou sans pression
- ▶ Toxicité potentielle
- ▶ plus cher

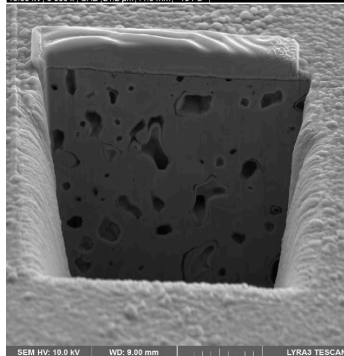
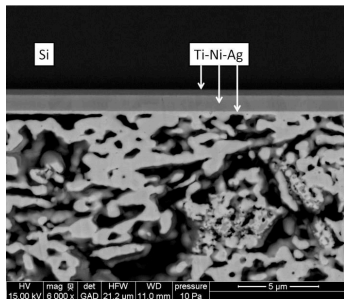
- ▶ Microparticules

- ▶ frittage forte pression (40 MPa), parfois sans pression possible
- ▶ peu cher, non toxique

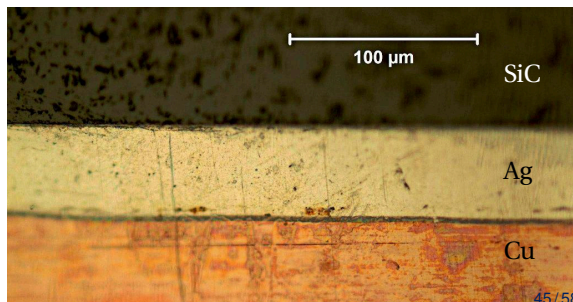
Mais il y a aussi des hybrides :

- ▶ additifs qui libèrent des nanoparticules pour favoriser le frittage
- ▶ Ajout de résine pour combler les vacuoles, fritter sans pression et permettre l'adhésion sur silicium

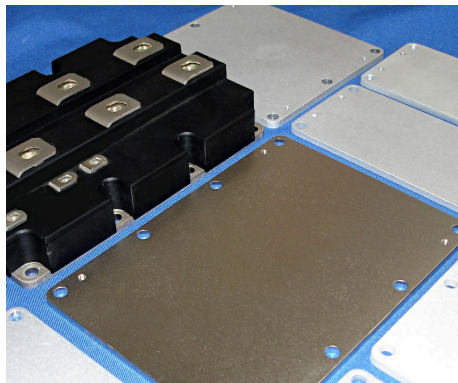
# Attaches frittées [6, 7, 8]



- ▶ Procédé robuste (sous air)
- ▶ Robuste en cyclage et vieillissement
  - ▶ La haute température poursuit le frittage
  - ▶ Pas d'intermétalliques
  - ▶ Finition idéale : Ag
- ▶ Joints plus ou moins poreux
  - ▶ Attention à la mesure de porosité



# Semelle



Source : <http://www.alsic.com>

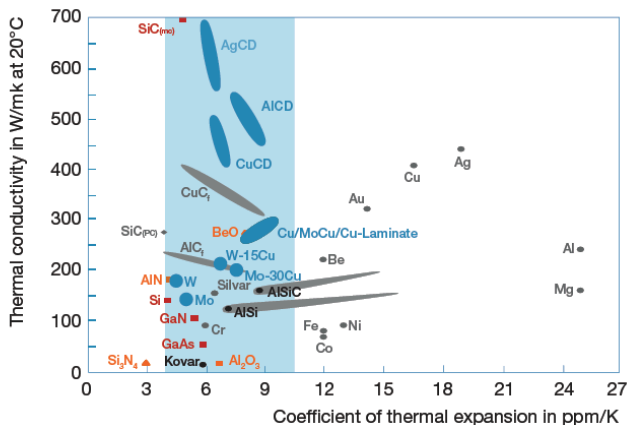
## Rôles :

- ▶ Support mécanique
  - ▶ Boulonnage sur radiateur
  - ▶ Brasure des substrats
- ▶ Gestion thermique
  - ▶ faible résistance substrat-radiateur
  - ▶ étalement de la chaleur

## Critères :

- ▶ Poids
- ▶ Conductivité thermique
- ▶ Coût
- ▶ Coefficient de dilatation

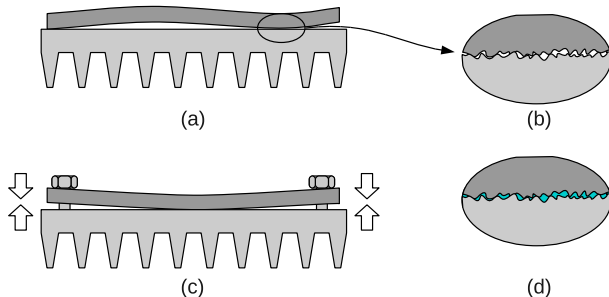
# Semelle – Choix des matériaux



Source : Packaging Materials, J. Popović-Gerber, ECPE tutorial on power electronics packaging, Lyon, 31/05/2011

- ▶ Les matériaux composites permettent de fixer le coefficient de dilatation
- ▶ L'AlSiC est couramment utilisé dans les transports

# Matériaux d'interface thermique

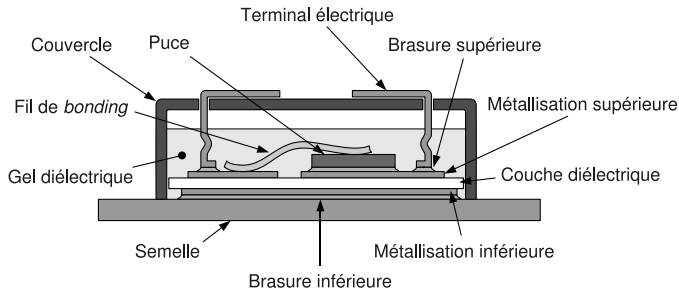


## La “pâte thermique”

- ▶ Interface semelle/radiateur
- ▶ Comble les vides
- ▶ Mauvais conducteur thermique ! (1 W/m.K contre 400 pour le cuivre !)

D'autres technologies existent pour les Thermal Interface Materials (TIM)

# Et le reste ?



## Nombreux autres éléments

- ▶ Les matériaux d'encapsulation (gels, résines)
- ▶ Les boîtiers (plastiques, hermétiques, . . .)
- ▶ Les terminaux (brasés, pressés, intégrés . . .)
- ▶ L'environnement plus éloigné (second level packaging)



# Sommaire

Introduction

Petit lexique du packaging de puissance

Considérations physiques

Aspects thermiques

Aspects thermo-mécaniques

Aspects électriques

Éléments de technologie

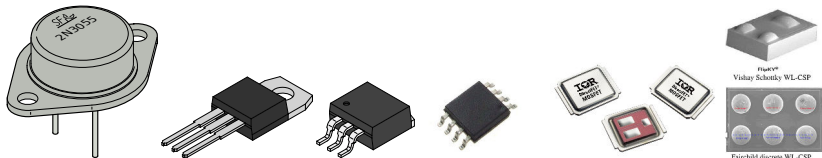
Substrats

Interconnexions

Gestion thermique

Évolutions, Recherche et Développement

# Évolution des composants discrets

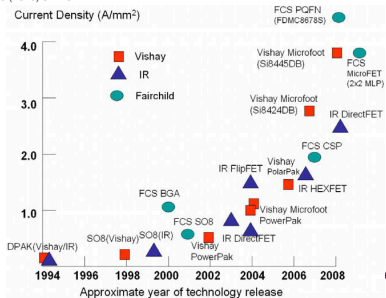


source : wikimedia commons pour tous les boîtiers sauf le Directfet, International Rectifier, et le WL-CSP, voir ci-dessous

Package type	Volume (mm <sup>3</sup> )	molding compound%	silicon %	leadframe %	interconnect %
DPAK	90	75	4	20	1
SO8 (wire)	28	83	6	10	1
SO8 (clip)	28	70	6	20	2
MOSFET BGA	20	0	40	50	10
WL-CSP	20	0	82	0	18

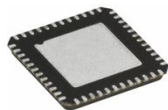
source : "Trends of power semiconductor wafer level packaging", Yong LIU, Microelectronics Reliability 50 (2010) 514-521

- ▶ Disparition graduelle du packaging de premier niveau (FLP)
- ▶ Les étapes de fabrication se font directement sur le wafer, avant découpe.



# Après le *flip-chip*, l'enterré

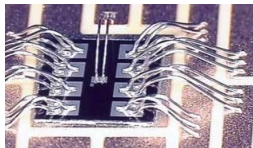
## Interconnect Evolution



chip & wire



established since  
40 years

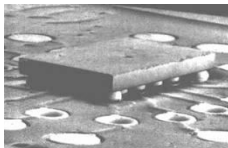


First level chip interconnection technologies inside a package:

flip chip



smallest in 2D



chip embedding



smallest in 3D

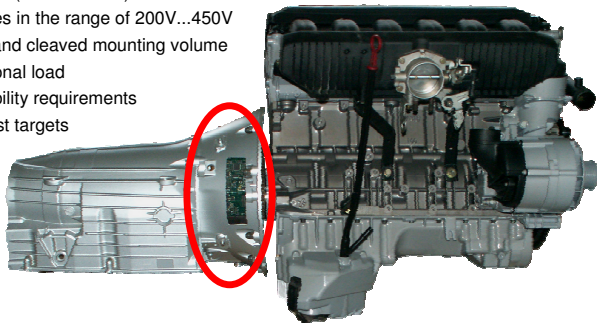


Advanced Power Electronics Packaging Workshop, Paris, France, September 30, 2009  
Lars Böttcher, System Integration & Interconnection Technologies  
lars.boettcher@izm.fraunhofer.de

# L'intégration mécatronique – exemple automobile

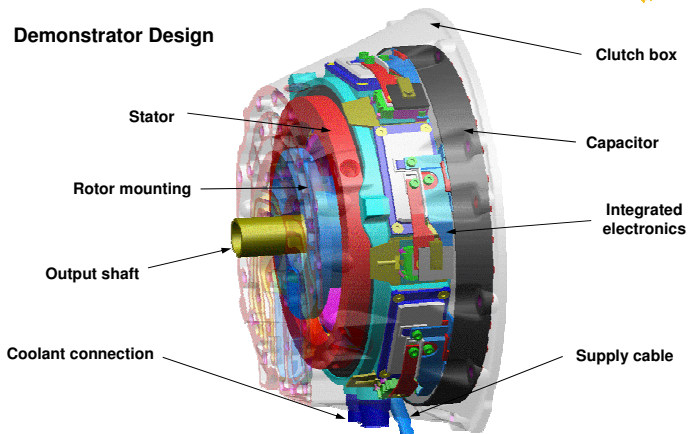
## Requirements for power electronics used in the automotive power train:

- Coolant temperature up to 115°C
- Ambient temperature in the engine compartment up to 140°C
- High currents (several 100A)
- High voltages in the range of 200V...450V
- Very small and cleaved mounting volume
- High vibrational load
- Tough reliability requirements
- Very low cost targets

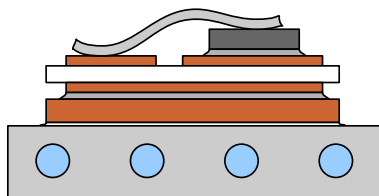


# L'intégration mécatronique – exemple automobile 2

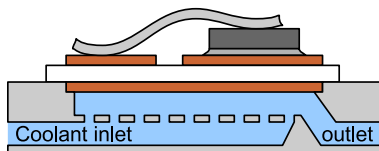
## Demonstrator Design



# Le refroidissement intégré



Classical liquid-cooling



Direct cooling

Mettre le fluide de refroidissement en contact direct avec le substrat

- ▶ Suppression de couches :
  - ▶ plaque à eau
  - ▶ pâte thermique
  - ▶ semelle
  - ▶ brasure
- ▶ Pas de contraintes mécaniques (interface liquide-solide)
- ▶ La plaque à eau peut être en plastique

# Conclusion

- ▶ Le packaging est un (sinon le) point limitant les performances des systèmes d'électronique de puissance
  - ▶ En tenir compte en phase de design
  - ▶ Beaucoup de degrés de liberté pour optimiser votre système
- ▶ C'est un sujet transversal (électricité, mécanique, thermique, matériaux. . .)
  - ▶ Très peu de personnes ont ce type de formation
  - ▶ Ces compétences sont demandées par beaucoup d'industriels (pas uniquement fabricants de modules)
- ▶ C'est un domaine en pleine évolution
  - ▶ une recherche et développement très active
  - ▶ Beaucoup d'acteurs européens

# Conclusion

- ▶ Le packaging est un (sinon le) point limitant les performances des systèmes d'électronique de puissance
  - ▶ En tenir compte en phase de design
  - ▶ Beaucoup de degrés de liberté pour optimiser votre système
- ▶ C'est un sujet transversal (électricité, mécanique, thermique, matériaux. . .)
  - ▶ Très peu de personnes ont ce type de formation
  - ▶ Ces compétences sont demandées par beaucoup d'industriels (pas uniquement fabricants de modules)
- ▶ C'est un domaine en pleine évolution
  - ▶ une recherche et développement très active
  - ▶ Beaucoup d'acteurs européens



# Conclusion

- ▶ Le packaging est un (sinon le) point limitant les performances des systèmes d'électronique de puissance
  - ▶ En tenir compte en phase de design
  - ▶ Beaucoup de degrés de liberté pour optimiser votre système
- ▶ C'est un sujet transversal (électricité, mécanique, thermique, matériaux. . .)
  - ▶ Très peu de personnes ont ce type de formation
  - ▶ Ces compétences sont demandées par beaucoup d'industriels (pas uniquement fabricants de modules)
- ▶ C'est un domaine en pleine évolution
  - ▶ une recherche et développement très active
  - ▶ Beaucoup d'acteurs européens

# References I



W. Sabbah, P. Bondue, O. Avino-Salvado, C. Buttay, H. Frémont, A. Guédon-Gracia, and H. Morel, "High temperature ageing of microelectronics assemblies with SAC solder joints," *Microelectronics Reliability*, 2017. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01564755>



W. Gale and D. Butts, "Transient liquid phase bonding," *Science and Technology of Welding and Joining*, vol. 9, no. 4, pp. 283–300, 2004. [Online]. Available : <http://www.ingentaconnect.com/content/maney/stwj/2004/00000009/00000004/art00001>



H. Greve and F. P. McCluskey, "LT-TLPS Die Attach for High Temperature Electronic Packaging," in *Proceedings of the High Temperature Electronics Network (HiTEN)*. Oxford, UK : IMAPS, Jul. 2013, pp. 246–253.



D. Bernache-Assollant and J.-P. Bonnet, *Frittage : aspects physico-chimiques - Partie 1 : frittage en phase solide*. Techniques de l'ingénieur, 2005, vol. AF 6 620, ch. Physique Chimie, p. 10. [Online]. Available : <http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/sciences-fondamentales-th8/fondamentaux-en-chimie-42106210/frittage-aspects-physico-chimiques-af6620/>



G. Bai, "Low-Temperature Sintering of Nanoscale Silver Paste for Semiconductor Device Interconnection," Ph.D. dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, Oct. 2005. [Online]. Available : <http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-10312005-163634/unrestricted/Dissertation-GBai05.pdf>



A. Masson, W. Sabbah, R. Riva, C. Buttay, S. Azzopardi, H. Morel, D. Planson, and R. Meuret, "Die attach using silver sintering. Practical implementation and analysis," *European Journal of Electrical Engineering*, vol. 16, no. 3-4, pp. 293–305, 2013. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00874465>



J. Billore, S. Hascoët, R. Robutel, C. Buttay, and J. Li, "Sintered-Silver Bonding of High-Temperature Piezoelectric Ceramic Sensors," *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, pp. 1–7, 2016. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01419042>

# References II



S. Hascoët, "Mise en œuvre de nouveaux matériaux d'assemblage dans les modules multipuces de puissance (MCM)," Ph.D. dissertation, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Villeurbanne, Nov. 2013.